

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种中频磁控溅射法制备纳米硅薄膜的溅射装置

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
106	0	0

**作者** 肖金泉, 高俊华, 闻立时, 张林, 石南林, 宫骏 and 孙超**发表日期** 2012-05-30**专利国别** 中国**专利类型** 实用新型**权利人** 中国科学院金属研究所**中文摘要** 本实用新型涉及硅薄膜材料的制备领域,具体的说是一种中频磁控溅射法制备纳米硅薄膜的溅射装置。包括真空室、抽气装置,其特征在于:所述溅射真空装置内设有非平衡态向下溅射的平面孪生硅靶,孪生硅靶下方设有基片加热台,基片加热台与孪生硅靶之间设有挡板,基片加热台下方设有一串联的电磁线圈组。本实用新型采用外加电磁线圈连续调整孪生靶的非平衡度,实现了低功耗下纳米硅薄膜高速率的离子辅助沉积,薄膜晶体结构大范围可控、光学带隙可调。**公开日期** 2012-05-30**语种** 中文**专利申请号** CN202246841U**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/67892>] **专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所**推荐引用方式** 肖金泉, 高俊华, 闻立时, 张林, 石南林, 宫骏 and 孙超. 一种中频磁控溅射法制备纳米硅薄膜的溅射装置. 2012-05-30.  
**GB/T 7714**[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824  
号-8

甘公网安备 62010202001088号